# 双层钨丝阵的 Z 箍缩动力学过程研究\*

宁 成 丁 宁 刘 全 杨震华

(北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088) (2005年10月8日收到,2005年11月16日收到修改稿)

基于 Z 箍缩零维模型、丝阵碰撞假设和箍缩动能最大化的优化原则,对美国 Sandia 实验室 Z 装置的典型双层 钨丝阵负载进行了优化分析 结果表明它基本上是优化的.在丝阵碰撞假设下 利用一维三温辐射磁流体力学程序 对其箍缩过程进行了数值模拟 模拟结果再现了 Z 箍缩过程的一维时空演化过程,得到了内外层丝阵的运动轨迹 和驱动电流在它们之间的转移规律,并将计算得到的宏观结果与实验结果进行了比较.表明丝阵相互作用的碰撞 假设有合理性.

关键词:Z箍缩,双层钨丝阵,零维模型,一维辐射磁流体 PACC:5225P,5230,5265

## 1.引 言

提高Z箍缩辐射功率的主要障碍是在箍缩过程 中产生的 RT (Rayleigh-Taylor)不稳定性和不对称 性.目前,克服这一障碍的实用技术就是在层内引进 一个附加的质量层(如内层喷气、内层丝阵)1-31.在 实验上该技术就喷气4]和丝阵[5]负载均进行了试 验 并取得了预期的效果 特别是在双层钨丝阵负载 实验上获得了 X 射线辐射功率增加 40% 的里程碑 性结果,引进附加的内层质量,改变了该区域的质量 分布,产生了向内的质量梯度.从纯流体力学上,这 样的质量分布能抑制 RT 不稳定性的进一步发 展<sup>[236]</sup>.但关于两层丝阵在箍缩过程中是如何相互 作用以及其电流是如何分配和转移等问题,虽然进 行了许多研究,但至今仍然不十分清楚,目前,关于 双层丝阵的相互作用存在两种不同的观点:1)壳层 碰撞模型 ,它认为内外层丝阵在箍缩的初始阶段均 已形成等离子体壳 随着箍缩的进行 外壳层与内壳 层发生非弹性碰撞7832)穿透模型(亦称电流转换 模型) 定认为内层丝阵在箍缩的初始阶段没有形成 等离子体壳 而是以丝阵的形式存在 外层丝阵等离 子体(壳层或单丝等离子体)随着箍缩的进行而逐渐 穿过内层丝阵 当穿透结束后外层丝阵的电流转移 到内层丝阵上 接着内层丝阵同单层丝阵箍缩行为

一样进行箍缩。—111.实际上两丝阵细致的相互作用 过程是复杂的,它与负载和电极的结构、负载材料、 驱动电流水平等因素有关,不宜一概而论,需要就不 同情况和不同箍缩阶段进行区别对待.由于即使内 层丝阵的电流很小,甚至没有电流,但在外层丝阵等 离子体穿透内层丝阵的过程中也会对它产生溅射和 消融作用,从而可能在外层丝阵仅部分通过时,内层 丝阵能形成"芯-晕"结构的近壳层结构,因此,我们 认为在 Z 箍缩的初始阶段有等离子体的穿透,而在 主要的箍缩物理过程中以碰撞为主.

但本文为了考察壳层碰撞模型的有效性,从壳 层纯碰撞模型出发,对美国 Sandia 实验室 Z 装置的 典型双层钨丝阵实验<sup>[5]</sup>的负载进行优化分析,并对 其 Z 箍缩过程进行一维辐射磁流体力学数值模拟, 以揭示在碰撞模型假设下的双层负载设计及其 Z 箍 缩过程的主要规律和总体特征.

### 2. 负载的优化分析

基于零维模型和内爆动能最大化的优化原则, 文献 12 对单层丝阵(喷气)负载进行了优化计算. 这里认为双层丝阵相互作用为非弹性碰撞,用相同 的方法对 Z 装置上的典型双层丝阵负载(内外丝阵 半径:1cm/2 cm;内外层丝数:120/240;内外层丝阵 线质量(1027µg/cm)(1846µg/cm).它产生了脉宽为

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:10375010和10575014)资助的课题.



图 1 内爆动能随内层丝阵线质量和半径的变化



图 2 内爆动能随外层丝阵半径和线质量的变化

首先,固定外层丝阵的半径(2cm)和线质量 (1846 $\mu$ g/cm).对于某一定的内层线质量,然后改变 其半径,而得到内爆动能随半径的变化.结果如图 1 所示.从图 1 中可见,对于任一固定的内层丝阵半 径,最后的内爆动能随内层丝阵线质量的减小而增 大,这表明引进内层丝阵要降低内爆动能或内爆速 度.这是引进内层丝阵能抑制不稳定性、提高 X 射 线功率所付出的代价.对于一定的内层丝阵线质量, 有一个最优的内层丝阵半径.内层线质量 $m_{in} =$ 1027 $\mu$ g/cm,当内层丝阵初始半径 $r_{in0} =$  1.4cm时,内 爆动能达到最大值 980kJ/cm,但当 $r_{in0}$ 在 1.0cm— 1.6cm变化时,内爆动能的降低均不超过 1%.因此, 在负载设计时这些半径都是可以选用的,但 $r_{in0} =$ 1.0cm设计出的负载具有很好的对称性,而且钨丝

其次,固定内层丝阵的半径(1cm)和线质量 (1027µg/cm).对于某一定的外层丝阵半径,然后改 变其线质量 从而得到内爆动能随线质量的变化情 况,结果如图2所示,从图2中可见,对于一定的外 层丝阵半径,有一个最优的外层丝阵线质量,并且该 最优线质量随半径的增大而变小 在最大动能附近 内爆动能随线质量变化亦随半径的增大而愈剧烈. 当外层丝阵半径 r<sub>aul</sub> = 2.0cm 时,内爆动能最大值所 对应的线质量为 1500µg/cm,此时内爆动能达到了 1005kJ/cm ;当外层丝阵线质量 mau 分别取为 1200µg/ cm,1800µg/cm,2000µg/cm时,内爆动能分别变为 1000kJ/cm /982kJ/cm /966kJ/cm ,与最大值相比 ,降低 不超过4%.在负载设计时该范围的线质量都是可 以考虑的.但因非弹性碰撞所损失的动能随 m\_\_\_的 增大而减少 因此 m 宜适当往大取.当外层丝阵线 质量 m<sub>out</sub> = 1846µg/cm 时,其初始半径为 1.6cm 时内 爆动能达到最大 1050kJ/cm ,而当其初始半径分别为 1.2cm ,1.4cm ,1.8cm ,2.0cm 时,内爆动能分别为 1100kJ/cm,1045kJ/cm,1030kJ/cm,980kJ/cm.内爆动 能随外层丝阵半径的变化小于 7%,变化仍然不是 很大.但 r<sub>aut</sub> = 2.0cm 设计出的负载具有很好的对称 性 而且钨丝( 直径 7.5µm )间隙合适(~0.5mm ). 此 外,当外丝阵的初始半径分别取为 2.2cm 2.4cm 时, 它们所对应的内爆动能分别下降到了 900kJ/cm 和 820kJ/cm 表明初始半径偏大了.

## 3. 箍缩过程的一维辐射磁流体力学模拟

双层丝阵相互作用的碰撞模型认为,在电流预 脉冲阶段它们都已形成了等离子体壳层.在 t = 0 时 Z 箍缩负载区域及其初始密度分布如图 3 所示. 区域 I 表示内层丝阵内界面所包围的空间,它的初 始密度由内层和外层丝阵的先驱等离子体所组成; 区域 II 表示内层丝阵所形成的等离子体壳层(厚 1mm);区域III表示由内层丝阵的外界面和外层丝阵 的内界面所包围的空间,它的初始密度由外层丝阵 的先驱等离子体组成;区域Ⅳ表示外层丝阵所形成 的等离子体壳层(厚 1mm).利用我们的一维辐射磁 流体力学程序<sup>[13]</sup>,对该初始密度分布的负载在文献 [5]的图 2 中驱动电流的作用下的 Z 箍缩过程进行 了数值模拟.在计算中,假定内外层丝阵分别有 4.5%和7%质量的材料已形成了先驱等离子体.图

报

55 卷

45和6反映了双层丝阵的Z箍缩动力学过程,图4是内外层丝阵的内外界面在箍缩过程中的运动轨迹 和收缩比 $(r_{out}/r_{out}(t))$ 随时间的变化 图 5 是双层丝 阵各界面的运动速度随箍缩过程的变化情况:图 6 是内外层丝阵和负载总动能随箍缩过程的变化情 况.各图中的数字(表示拉氏网格点序号)143,60, 55 5 分别表示外层丝阵的外、内界面和内层丝阵的 外、内界面, E<sub>K</sub>, E<sub>KII</sub>和 E<sub>KIV</sub>分别表示负载总动能和 内、外丝阵的动能,外层丝阵的外界面从t = 40ns 后 开始明显地向内箍缩,但它的内界面要到 t = 55ns 后才明显地向内箍缩,并且在此后的 40ns 内以比外 界面更快的速度向内运动;t = 100ns 后,内层丝阵开 始迅速地向内运动,而此前它基本上处于原地不动; t = 105ns 后外丝阵的内界面开始减速,同时内层丝 阵的箍缩速度迅速增大 ,表明内外层丝阵的非弹性 碰撞开始,但外层丝阵的动能还没有下降,而到 t = 115ns 后,外层丝阵的外界面速度也开始下降,此时 外层丝阵的动能也开始下降,内层丝阵的动能开始 迅速增大;t = 120ns 后,内外两层丝阵已被压得非常 紧了 外层丝阵的内界面和内层丝阵的外界面合二 为一,并开始以相同的速度向内运动;t = 127ns 后, 整个负载由内而外逐渐开始减速 随后动能也逐渐 开始下降 ,到 t = 144 ns 时 ,负载的总动能下降到零 , 并辐射出超强的 X 射线脉冲(见图 7);此后负载开 始向外飞散,但由于此时的电流又在增加,使得磁压 又大于热压力,从而又开始箍缩,计算结果表明外丝 阵的最大收缩比为 27 最大内爆速度和动能分别达 到了  $6 \times 10^7$  cm/s 和 430kJ.



图 3 初始密度的分布

图 7 给出了实验的负载电流和 X 射线辐射脉冲( 实线)以及我们计算出的 X 射线辐射脉冲波形 ( 虚线 ).从图中可见,计算出的辐射功率( 120TW )比 实验值小,并且最大值时刻( 144ns )比实验值推迟了 4ns,脉宽( 3.9ns )同实验值相当.对计算出的 X 射线 脉冲功率曲线积分得 X 射线能量为 0.8MJ,也比实 验值小,说明程序计算在定量符合上还要进一步提



图 4 双层丝阵的内爆轨迹







图 6 内外层丝阵及负载箍缩动能随时间的变化

高 ,需要更全面地考虑 X 射线辐射的产生及其输运 过程.图 8 是内外层丝阵等离子体的平均电离度随 箍缩过程的变化情况.图中标志不同曲线的数字表 示计算网格中不同的拉氏点 ,142 ,100 ,70 拉氏点在 外层丝阵内 ,50 ,25 ,10 拉氏点属内层丝阵.由于外 层丝阵的欧姆加热和磁压做功都比内层的大 ,因此 它的离子(原子)被电离得早一些 ,同一时刻的电离 度也大一些.在箍缩到心时最大电离度达到了 65, 说明电离到了 W 离子的第 L 层的电子(平均地仅一 个 L 层的电子被电离).因此,其所产生的 X 射线主 要是 M N O P Q 等层的 X 射线辐射.



图 7 负载电流和 X 射线辐射脉冲波形



图 8 平均电离随箍缩过程的变化

图9展示了各计算区域中质量密度的一维时空 演化情况.从图9中可以看到 t = 96.4ns 以前,尽管 外层丝阵在不断地向内层丝阵运动,但内层丝阵的 位置和密度分布几乎没有变化,同初始的位置和密 度分布一样;t = 113ns 时,由于外层丝阵的碰撞和挤 压,使得内层丝阵向内运动,密度增加;t = 120ns 后, 两个丝阵已被紧紧地压在一起,像一个丝阵一样向 内箍缩.最大压缩密度为0.8g/cm<sup>3</sup> 左右,曲线 f 表示 负载已向外飞散.图 10 反映了两丝阵在箍缩过程中 的接近程度以及驱动电流在各等离子体区域的分配 情况.电流密度可以通过磁场的空间变化计算出 来<sup>[14]</sup> 积分各区域的电流密度,就可以得到各区域 所携带的电流.开始时,由于区域 [] 的电流(I<sub>n</sub>)横



图 9 密度在箍缩过程中的时空演化过程

截面积最大(比区域 II 大几倍),并且内外层丝阵几 乎都在原地不动,没有磁场对流,再加上脉冲电流的 趋肤效应,使得开始时大部分电流都从外层丝阵所 形成的等离子体中流过,但 *t* = 55ns 后,因外层丝阵 的内界面向内运动,从而磁场(进而电流)通过流体 对流到区域 III 中;到 *t* = 105ns 后,因整个内层丝阵 开始向内运动,从而磁场(进而电流)通过流体对流 到区域 II 和 I 中,并使得区域 IV 中的电流开始下降; *t* = 120ns 后,因外层丝阵的内界面和内层丝阵的外 界面以相同的速度运动(见图 5),从而磁场的对流 开始减小,进而区域 III,II,I中的电流都开始下降, 区域 IV 中的电流开始增加,并因趋肤而进一步增加, 以致最后驱动电流主要从区域 IV 中流过.



图 10 两丝阵的相对位置和各区电流随箍缩过程的变化 (I总电流, $\prod, \prod, \prod n$ )区的电流分别为  $I_{I}$ , $I_{III}$ , $I_{IIII}$ )

#### 4. 讨论

双层丝阵不像单层丝阵那样能直接地给出负载 的优化结果,而需要进行综合分析和考虑.但是从 前面的负载优化分析发现,在单层丝阵内引入一个 内层丝阵后,将使内爆动能下降,因此基于内爆动 能最大化的优化原则,应首先在相同的驱动电流下 优化外层丝阵,然后再在此基础上确定内层丝阵的 位置和线质量;丝阵的半径和线质量在一定的范围 内变化时,内爆动能变化不大,从而给负载的设计、 制造工艺和加工等提供了便利的空间.一般地,在外 层丝阵已基本上优化的基础上,内层丝阵的半径和 丝数可以直接取为外层丝阵相应参数的一半即可. 这样设计出的双层丝阵具有很好的对称性,并且内 外层的丝间隙相同,它基本上是优化的.

内外层丝阵的非弹性碰撞要损失外层丝阵已获 得的动能 损失的动能一方面增加内层丝阵的动能, 另一方面增加内外层丝阵等离子体的内能,并有一 部分以 X 射线的形式辐射出去,对于本文研究的 Z 装置上的典型双层负载 参数如前面所述),零维计 算结果表明:外层丝阵碰到内层丝阵的时刻和速度 分别为 113ns 和 4.89 × 10<sup>7</sup> cm/s(一维计算结果分别 为 105ns 和 4 × 10<sup>7</sup> cm/s,见图 5) 损失的动能为 80kJ (从一维计算结果图 6 中估算出的动能损失大于 30kJ);收缩比为 20 时的箍缩时刻和速度分别为 131ns 和 8.26 × 107 cm/s. 从实验测出的 X 射线脉冲 功率曲线 图 7 中的实线 )可以估算出在两丝阵碰撞 过程中产生的 X 射线能量为 50kJ 左右. 它比零维模 型计算出的动能损失小 但比一维计算的估算结果 要大,这是合理的.由于实验测出的 X 射线脉冲功 120ns) 因此,它是由丝阵碰撞而产生的,从而支持 丝阵相互作用的碰撞模型.但这里的数值模拟计算 未能模拟出该碰撞辐射平台,说明数值模拟中因采

用稀薄的先驱等离子体连接内外层丝阵等离子体而 弱化了该碰撞过程.

在丝阵相互作用的穿透模型中,当外层丝阵穿 透内层丝阵后外层电流直接转移到内层丝阵上.从 图 10 中也可以看到类似的电流转移过程,但碰撞模 型下的电流转移是由磁场的对流(可能还有扩散)而 引起的.电流转移在双层丝阵的后期箍缩过程中是 重要的,它使内层丝阵(等离子体)加速、升温等,使 箍缩继续进行.

### 5.结 论

用 Z 箍缩的零维计算模型,根据动能最大化的 优化原则和丝阵碰撞假设,对美国 Sandia 实验室 Z 装置上典型的双层钨丝阵负载进行了优化分析 给 出了内爆动能随内外层丝阵线质量和初始半径的变 化规律 表明该负载基本上是优化的,该优化分析方 法不仅适用于双层丝阵负载的优化分析 ,而且适用 于双层喷气负载,甚至更复杂的嵌套复合负载的优 化分析 并通过综合考虑可以得到优化(或近似优 化 的负载的设计方案.一维辐射磁流体力学程序对 其 Z 箍缩过程的数值模拟 模拟结果给出了它的时 空演化过程 展现了箍缩过程的总体动力学特征 发 现内层丝阵等离子体在与外层丝阵碰撞以前基本上 不动,在碰撞期间外层丝阵的电流通过对流大部分 转移到内层丝阵等离子体上 碰撞结束后 因电流的 趋肤效应,大部分电流又转移到外层等离子体上,由 于基于丝阵碰撞假设基础上的一维数值模拟的宏观 结果与实验的测量结果大致符合,丝阵运动的总体 特征合理,并且零维模型的计算结果如丝阵碰撞时 刻、运动速度、动能损失等也比较合理,特别是出现 X射线辐射前平台的时间,以及它的 X 射线能量同 丝阵碰撞动能损失相当,从而表明丝阵相互作用的 碰撞模型 假设 是合理的.

- [1] Gol 'berg S M , Velikovich A L 1993 Phys. Fluids B 5 1164
- [2] Velikovich A L , Cochran F L , Davis J 1996 Phys. Rev. Lett. 77 853
- [3] Velikovich A L, Cochran F L, Davis J, Chong Y K 1998 Phys. Plasmas 9 3377
- Baksht R B , Datsko I M , Kim A A , Labetskii A Yu , Loginov S V , Oreshkin V I , Russkikh A G , Fedunin A V , Shishlov A V 1995 *Plasma Phys. Rep.* 21 907
- [5] Deeney C , Douglas M R , Spielman R B , Nash T J , Peterson D L , Eplattenier P L , Chandler G A , Seamen J F , Struve K W 1998 Phys. Rev. Lett. 81 4883

- [6] Sze H, Janister J, Failor B H, Levine J S, Qi N, Velikovich A L, Davis J, Lojewski D, Sincerny P 2005 Phys. Rew. Lett. 95 105001
- [7] Lebedev S V, Aliaga-Rossel R, Bland S N, Chittenden J P, Dangor A E, Haines M G, Zakaullah M 2000 Phys. Rev. Lett. 84 1708
- [8] Peterson D L , Bowers R L , Matuska W , McLenithan K D , Chandler G A , Deeney C , Derzon M S , Douglas M , Matzen M K , Nash T J , Spielman R B , Struve K W , Stygar W A 1999 *Phys* . *Plasmas* 6 2178
- [9] Terry R E , Davis J , Deeney C , Velikovich A L 1999 Phys. Rew. Lett. 83 4305
- [ 10 ] Deeney C , Apruzese J P , Coverdale C A , Whitney K G , Thornhill J

W , Davis J 2004 Phys. Rew. Lett. 93 155001

- [11] Cuneo M E , Sinars D B , Bliss D E , Waisman E M , Porter J L , Stygar W A , Lebedev S V , Chittenden J P , Sarkisov G S , Afeyan B B 2005 Phys. Rev. Lett. 94 225003
- [12] Ning C Yang Z H, Ding N 2003 High Power Laser and Particle Beams 15 1200 (in Chinese)[宁 成、杨震华、丁 宁 2003 强 激光与粒子束 15 1200]
- [13] Ning C, Yang Z H, Ding N 2003 Acta Phys. Sin. 52 1650 (in Chinese)[宁 成、杨震华、丁 宁 2003 物理学报 52 1650]
- [14] Ning C Yang Z H, Ding N 2002 High Power Laser and Particle Beams 14 877 (in Chinese ] 宁 成、杨震华、丁 宁 2002 强激 光与粒子束 14 877 ]

## Studies of implosion processes of nested tungsten wire-array Z-pinch\*

Ning Cheng Ding Ning Liu Quan Yang Zhen-Hua

(Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088, China)
(Received 8 October 2005; revised manuscript received 16 November 2005)

#### Abstract

Nested wire-array is a kind of promising structured-load because it can improve the quality of Z-pinch plasma and enhance the radiation power of X-ray source. Based on the zero-dimensional model, the assumption of wire-array collision, and the criterion of optimized load (maximal load kinetic energy), optimization of the typical nested wire-array as a load of Z machine at Sandia Laboratory was carried out. It was shown that the load has been basically optimized. The Z-pinch process of the typical load was numerically studied by means of one-dimensional three-temperature radiation magneto-hydrodynamics (RMHD) code. The obtained results reproduce the dynamic process of the Z-pinch and show the implosion trajectory of nested wire-array and the transfer process of drive current between the inner and outer array. The experimental and computational X-ray pulse was compared, and it was suggested that the assumption of wire-array collision was reasonable in nested wire-array Z-pinch at least for the current level of Z machine.

Keywords : Z-pinch , nested tungsten-wire-array , 0-D optimizing , 1-D RMHD PACC : 5225P , 5230 , 5265

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant Nos. 10375010 and 10575014 ).